

第 100 回 金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 (ARS) 例会
— 最新技術が拓くアノード酸化による半導体表面微細加工 —

日時：平成30年8月28日（火）13：15～17：30

場所：首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス（JR「秋葉原駅」徒歩1分）

〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-18-13 秋葉原ダイビル 12 階

主催：（一社）表面技術協会・金属のアノード酸化皮膜の機能化部会（ARS）

協賛：日本化学会，電気化学会，化学工学会，日本表面真空学会，応用物理学会，精密工学会，エレクトロニクス実装学会，日本材料学会，日本セラミックス協会，日本トライボロジー学会など（予定）

代表的半導体であるシリコンのアノード酸化は，多孔質シリコンの室温可視発光の発見で一躍注目を浴びたのち，光学フィルタや微細構造形成のテンプレート，ドラッグデリバリー用の担体などに応用範囲を拡大しながら精力的に研究が進められてきました．近年では，金属を触媒とした半導体のエッチングも飛躍的な研究の進歩がみられ，新たな技術として確立されつつあります．また，化合物半導体のアノード酸化にも新たな展開が見られます．このような背景のもと，本部会における初の試みとして半導体のアノード酸化をテーマに例会を企画いたしました．今回は4名の講師から，化合物半導体のアノードエッチング，半導体の金属触媒エッチングと研磨，シリコン陽極酸化における応力制御と微細構造形成，太陽電池用シリコン加工についてご紹介いただき，半導体のアノード酸化とその応用の最先端へみなさまを誘います．アルミニウムやチタンなどの金属の場合とは趣を異にする，新たな視点でアノード酸化を見直す絶好の機会となるはずです．多数のご参加をお待ちしております．

合わせて，ミキサーは講師や参加者との情報交換・交流の場です．どうぞ，ご参加ください．

プログラム

13:15-13:20	開会挨拶	
13:20-13:35	趣旨説明	（京都大学）深見 一弘
13:35-14:25	アノードエッチングを用いた化合物半導体の微細加工	（工学院大学）阿相 英孝
14:30-15:20	ウェットエッチングによる半導体表面構造の極限制御 ～不動態化から触媒アシストエッチングまで～	（大阪大学）有馬 健太
15:20-15:40	休憩	
15:40-16:30	陽極酸化法を利用したシリコンウエハ表面のマикро曲げ加工技術	（神戸大学）青木 画奈
16:35-17:25	ポーラスシリコンのナノ構造を利用した低コスト，高効率太陽電池への アプローチ：低コスト剥離およびタンデムトップセルを目指して	（東京工業大学）伊原 学
17:25-17:30	閉会挨拶	
17:45-19:00	ミキサー（技術交流会）	

【申込】ARS部会ホームページ (<http://ars.sf.j.or.jp/>) からお申し込みください。

【参加費】ARS会員・学生：無料，一般：3,000円，ミキサー：3,000円 当日会場でお支払いください。

【申込締切】 8月10日（金）（申込多数の場合は早期に締め切ることがあります。）